

IV1Q12080T4 – 1200V 80mΩ SiC MOSFET

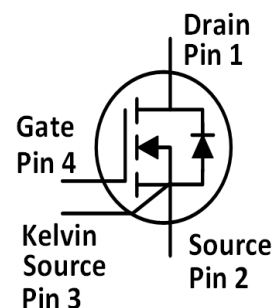
特点:

- 高压、低导通电阻
- 高速、寄生电容小
- 高工作结温
- 快速恢复体二极管

应用:

- 光伏逆变器
- UPS 电源
- 电机驱动
- 高压 DC/DC 变换器
- 开关电源

封装:



产品代码	封装形式
IV1Q12080T4	TO247-4

最大额定值 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	典型值	单位	测试条件	备注
V _{DS}	漏源电压	1200	V	V _{GS} =0V, I _D =100μA	
V _{GS}	栅源电压	-5 to 20	V	建议在此电压范围内工作	
I _D	最大漏源电流	42	A	V _{GS} =20V, T _C =25°C	图 21
		31	A	V _{GS} =20V, T _C =100°C	
I _{DM}	最大脉冲漏源电流	70	A	根据器件安全工作区确定	图 24
P _{TOT}	最大耗散功率	300	W	T _C =25°C	图 22
T _{stg}	存储温度范围	-55 to 175	°C		
T _J	工作结温范围	-55 to 175	°C		
T _L	焊接温度	260	°C	引线处波峰焊接, 距外壳 1.6 毫米, 持续不超过 10 秒	

热阻特性

符号	参数说明	典型值	单位	备注
R _{θ(j-c)}	结到外壳的热阻	0.5	°C/W	图 23

电学特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
I _{DSS}	关断时的漏极漏电流		5	100	μA	V _{DS} =1200V, V _{GS} =0V	
I _{GSS}	栅极漏电流			±100	nA	V _{DS} =0V, V _{GS} =-5~20V	
V _{TH}	阈值电压		3.6		V	V _{GS} =V _{DS} , I _D =3.8mA	图 8, 9
			2.7			V _{GS} =V _{DS} , I _D =3.8mA @ T _c =175°C	
R _{ON}	导通电阻		80	100	mΩ	V _{GS} =20V, I _D =10A @T _J =25°C	图 4, 5, 6, 7
			130		mΩ	V _{GS} =20V, I _D =10A @T _J =175°C	
C _{iss}	输入电容		1680		pF	V _{DS} =800V, V _{GS} =0V, f=1MHz, V _{AC} =25mV	图 16
C _{OSS}	输出电容		69		pF		
C _{rss}	反向传输电容		6.7		pF		
E _{OSS}	输出电容存储能量		27		μJ		图 17
E _{AS}	单脉冲雪崩能量		0.75		J	I _D =20A, V _{DD} =50V, L=2mH	
Q _g	栅极总电荷		76		nC	V _{DS} =800V, I _D =20A, V _{GS} =-5 to 20V	图 18
Q _{gs}	栅源电荷		29		nC		
Q _{gd}	栅漏电荷		34		nC		
R _g	栅极输入电阻		4.2		Ω	f=1MHz	
E _{ON}	导通能量		154		μJ	V _{DS} =800V, I _D =20A, V _{GS} =-3.5 to 20V, R _{G(ext)} =2.0Ω, L=290 μH	图 19, 20
E _{OFF}	关断能量		80		μJ		
t _{d(on)}	导通延迟时间		8.9		ns		
t _r	上升时间		19.9				
t _{d(off)}	关断延迟时间		14.7				
t _f	下降时间		9.5				

体二极管特性 (T_c=25°C, 特殊说明除外)

符号	参数说明	规范值			单位	测试条件	备注
		最小	典型	最大			
V _{SD}	正向电压		4.7		V	I _{SD} =10A, V _{GS} =0V	图 10, 11, 12
			4.2		V	I _{SD} =10A, V _{GS} =0V, T _J =175°C	
t _{rr}	反向恢复时间		10.2		ns	V _{GS} =0V, I _{SD} =20A,	
Q _{rr}	反向恢复电荷		64		nC	V _R =800V,	
I _{RRM}	反向恢复峰值电流		11.3		A	di/dt=1100A/us	

典型特征曲线:

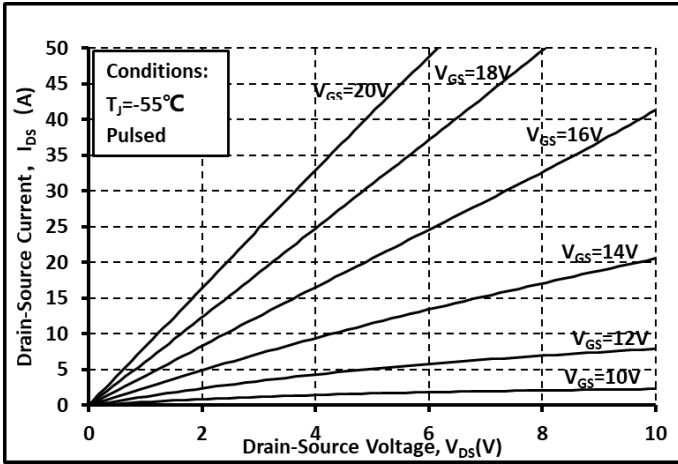


图. 1 输出曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

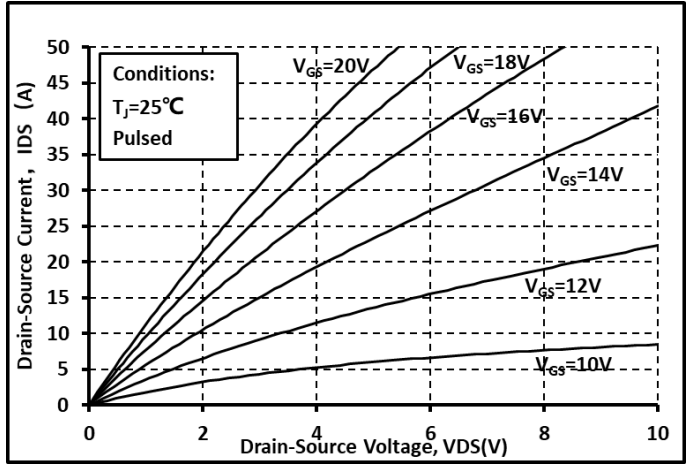


图. 2 输出曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

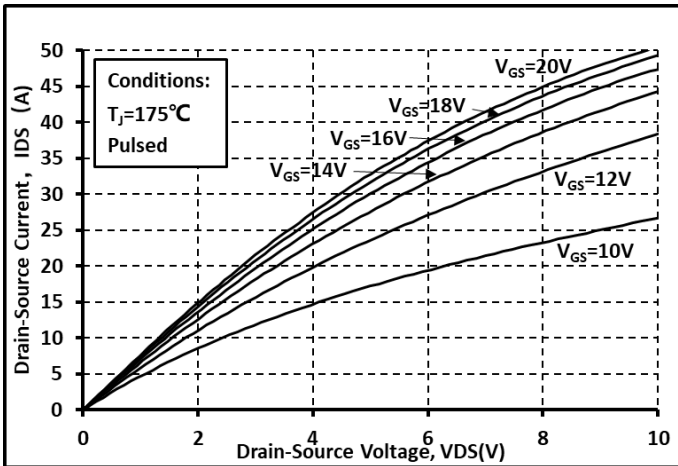


图. 3 输出曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

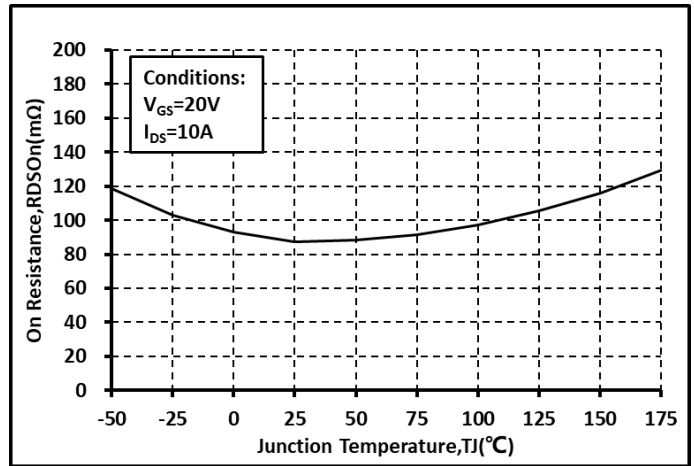


图. 4 Ron 和温度关系曲线

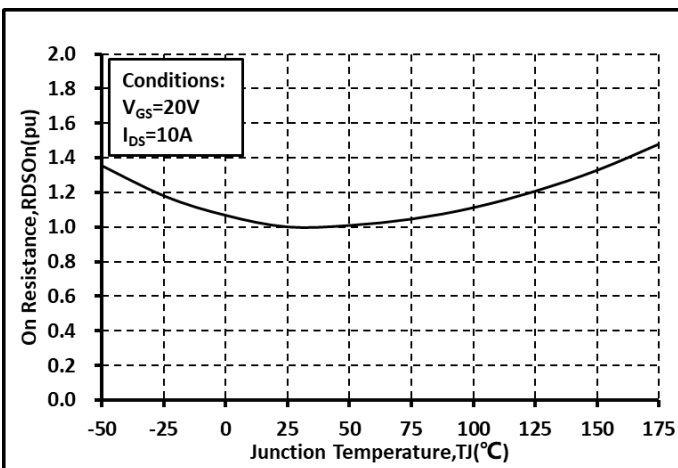


图. 5 归一化的 Ron 和温度关系曲线

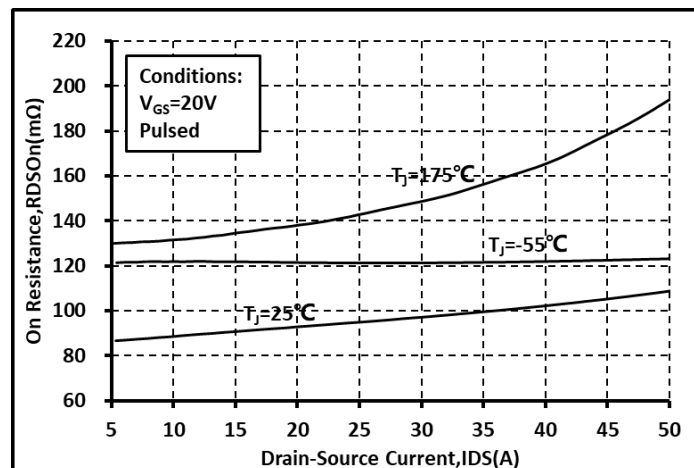


图. 6 各温度下的 Ron 和 Ids 关系曲线

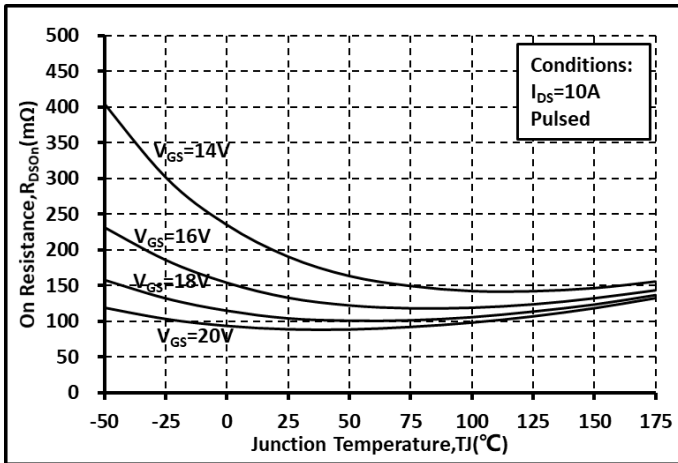


图. 7 各 V_{GS} 下的 R_{on} 和温度关系曲线

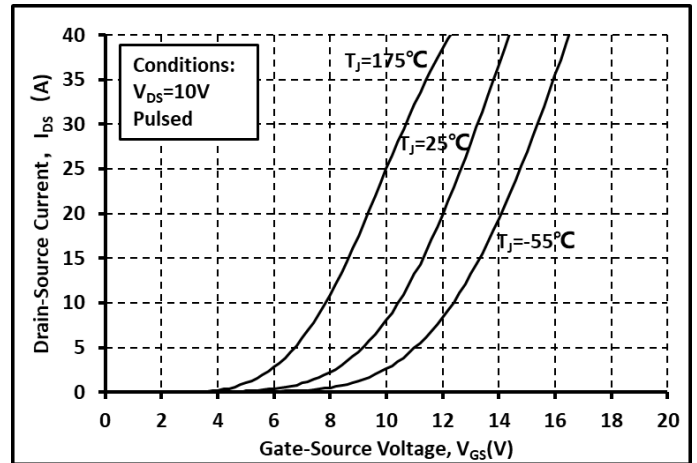


图. 8 各温度下的传输特性曲线

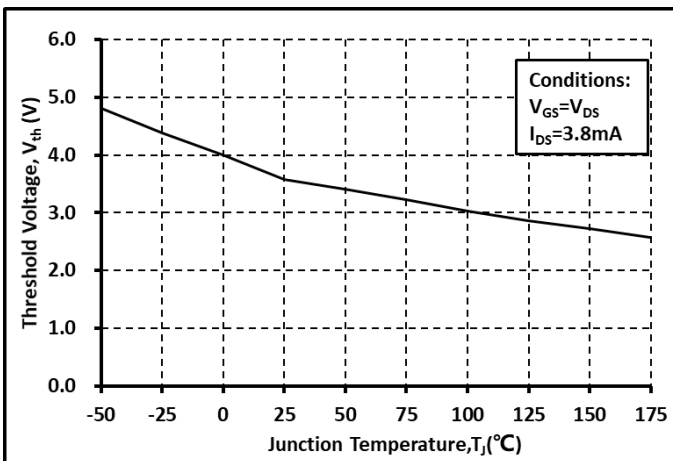


图. 9 阈值电压随温度变化曲线

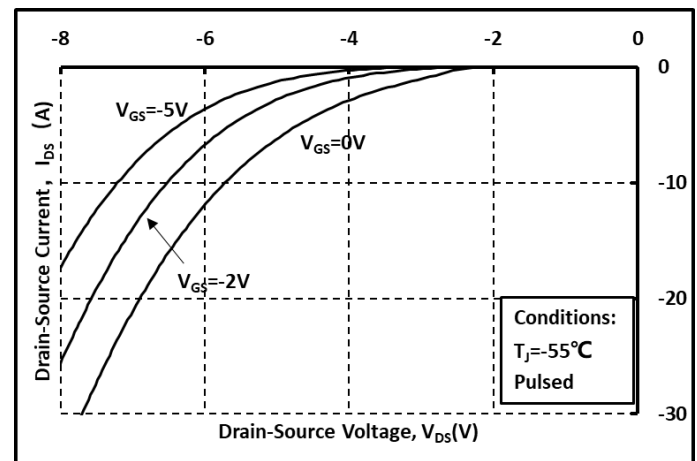


图. 10 体二极管导通曲线 @ $T_J = -55^\circ\text{C}$

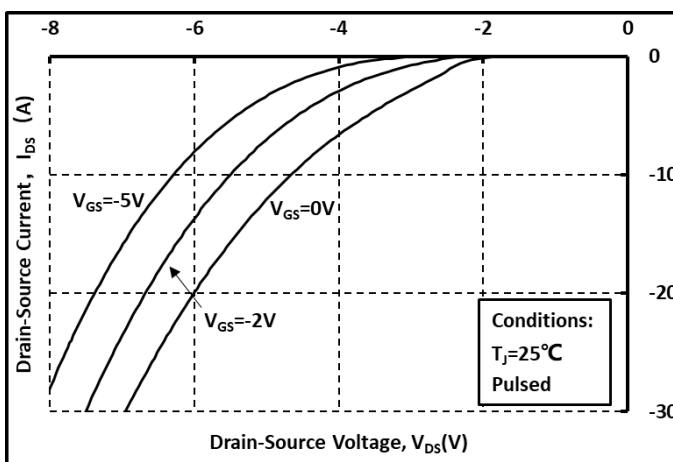


图. 11 体二极管导通曲线 @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

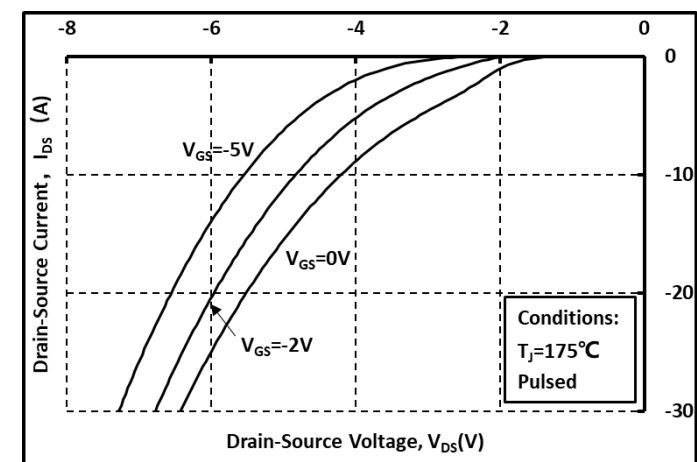


图. 12 体二极管导通曲线 @ $T_J = 175^\circ\text{C}$

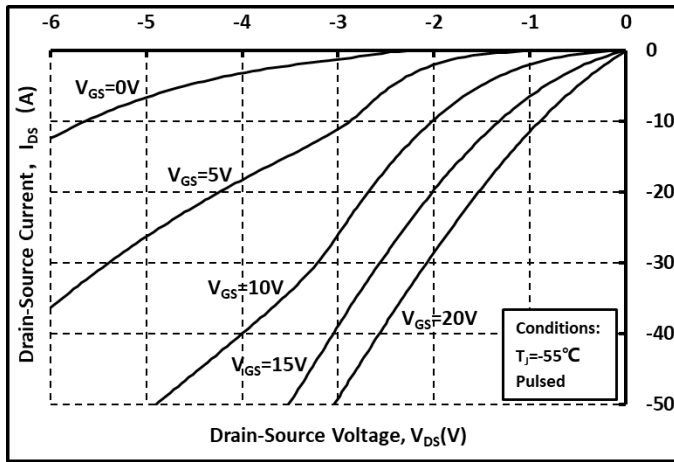


图. 13 第三象限曲线 @ $T_j = -55^\circ\text{C}$

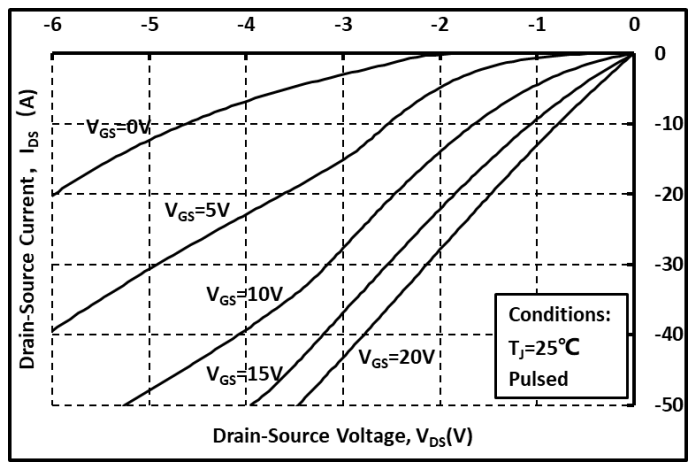


图. 14 第三象限曲线 @ $T_j = 25^\circ\text{C}$

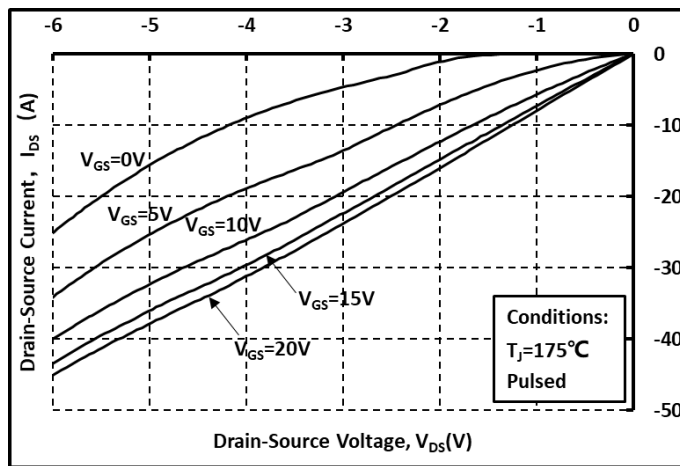


图. 15 第三象限曲线 @ $T_j = 175^\circ\text{C}$

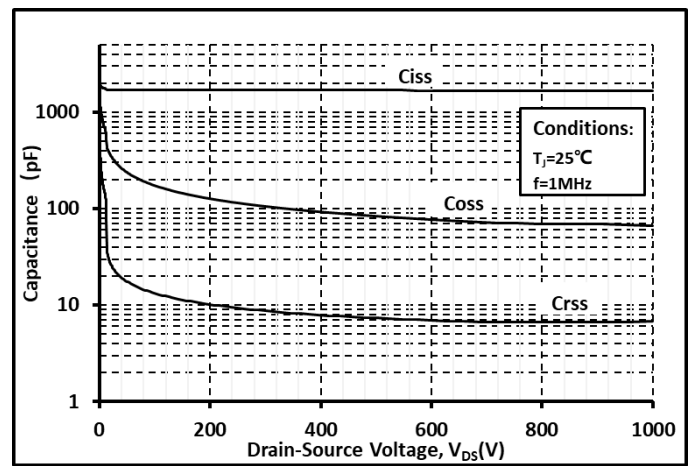


图. 16 各电容和 V_{DS} 关系曲线

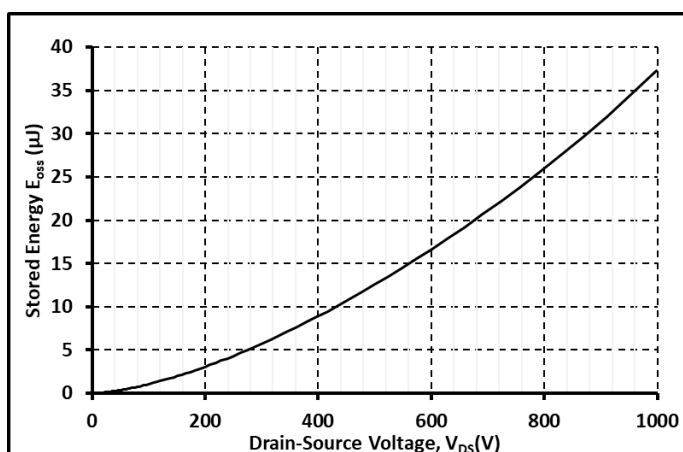


图. 17 输出电容存储能量曲线

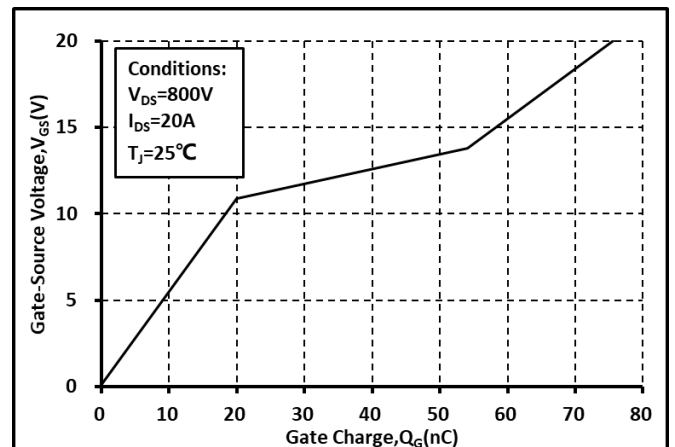


图. 18 栅电荷特征曲线

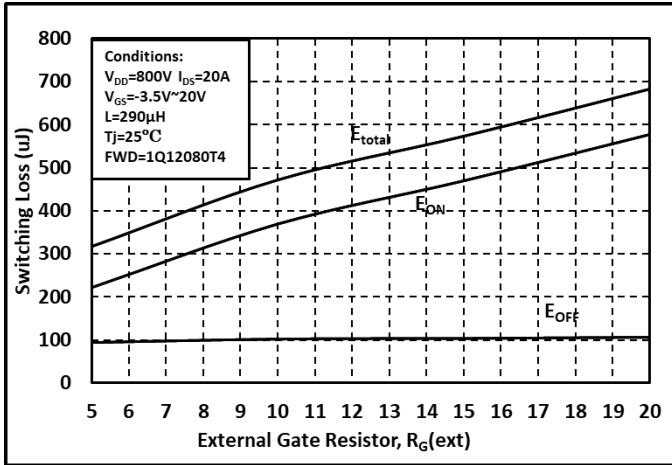


图. 19 开关能量和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

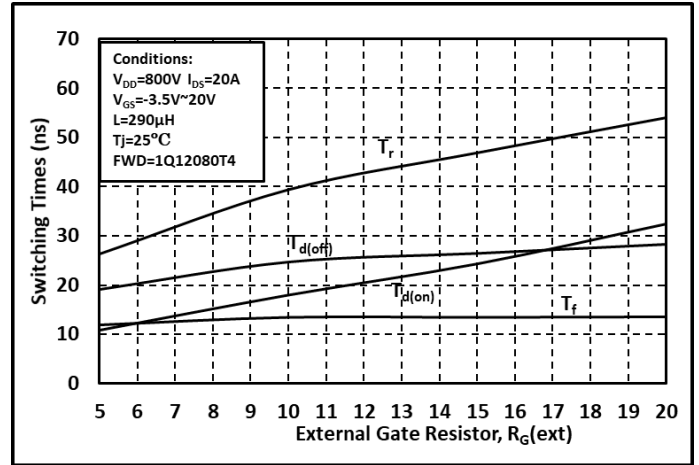


图. 20 开关时间和栅极电阻 $R_{G(ext)}$ 关系曲线

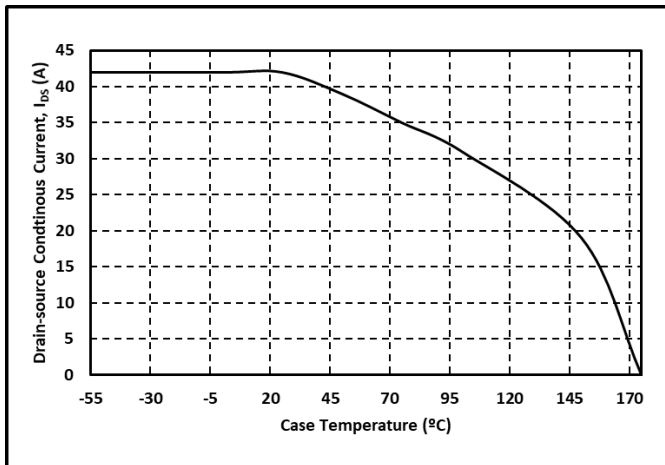


图. 21 漏端电流和温度关系曲线

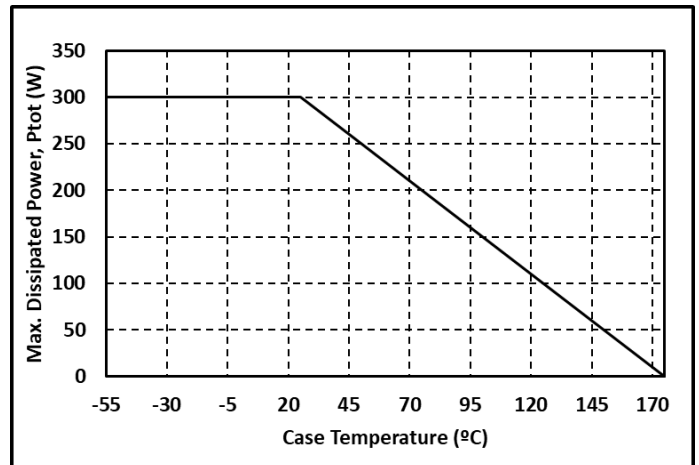


Fig. 22 最大功耗降额和温度关系曲线

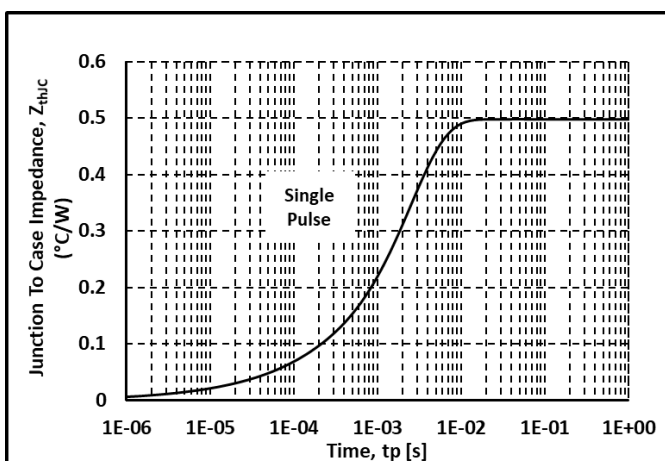


图. 23 热阻曲线

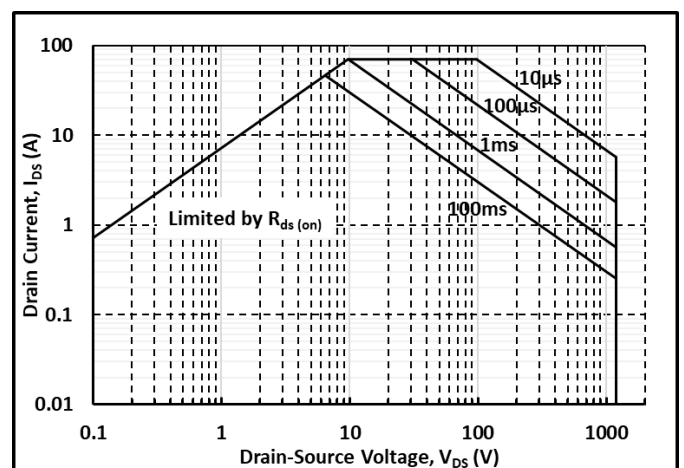
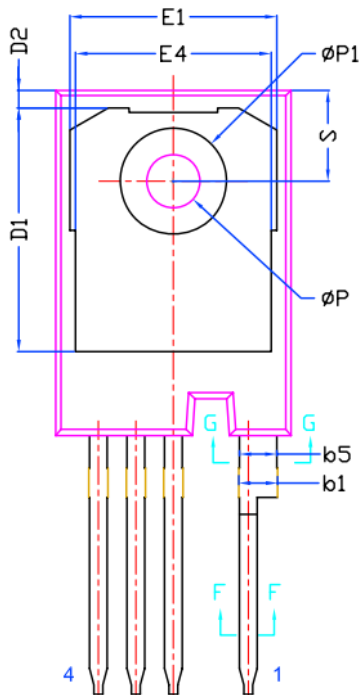
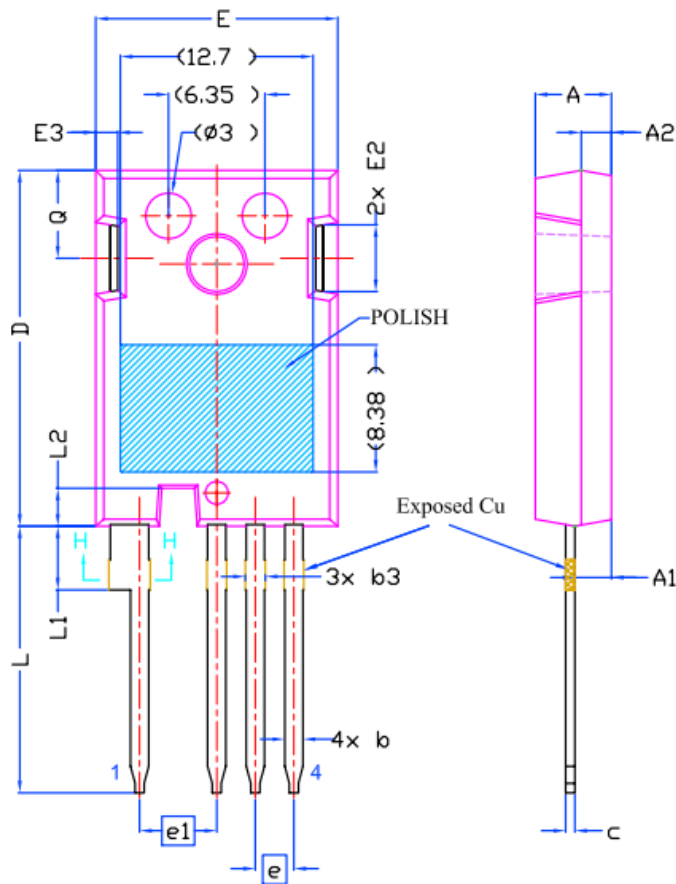
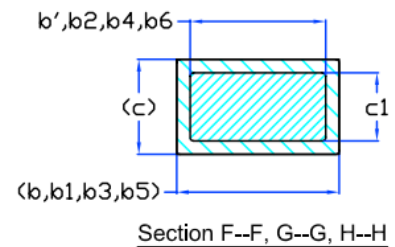
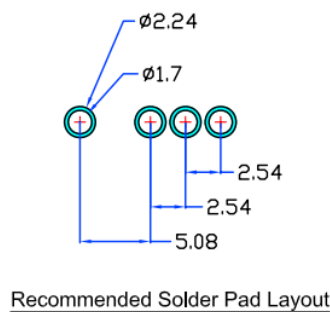


图. 24 安全工作区示意图

封装尺寸:



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	4.83	5.02	5.21
A1	2.29	2.41	2.54
A2	1.91	2.00	2.16
b'	1.07	1.20	1.28
b	1.07	1.20	1.33
b1	2.39	2.67	2.94
b2	2.39	2.67	2.84
b3	1.07	1.30	1.60
b4	1.07	1.30	1.50
b5	2.39	2.53	2.69
b6	2.39	2.53	2.64
c	0.55	0.60	0.68
c1	0.55	0.60	0.65
D	23.30	23.45	23.60
D1	16.25	16.55	17.65
D2	0.95	1.19	1.25
E	15.75	15.94	16.13
E1	13.10	14.02	14.15
E2	3.68	4.40	5.10
E3	1.00	1.45	1.90
E4	12.38	13.26	13.43
e	2.54 BSC		
e1	5.08 BSC		
L	17.31	17.57	17.82
L1	3.97	4.19	4.37
L2	2.35	2.50	2.65
øP	3.51	3.61	3.65
øP1	7.19 REF.		
Q	5.49	5.79	6.00
S	6.04	6.17	6.30



说明:

1. 封装标准参考: : JEDEC TO247, Variation AD
2. 以上单位为: 毫米
3. 需要开槽, 槽口可为圆形
4. 尺寸 D 和 E 不包括模具溢料

说明:

此版本为初始版本，如需最新资料，请联系公司相关人员或登录公司网站。

Copyright©2020 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

相关链接:

<http://www.inventchip.com.cn>



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Inventchip](#)